

고강도 나노 슬라이드가 증착된 나노 탐침 배열의 제작

Fabrication of nano-probe array covered with high strength nano-slide

정은희, 임상엽, 주홍렬, 박승한

연세대학교 물리학과

jeunh99@korea.com

근접장 측정에서 보편적으로 쓰이는 광섬유 탐침은 근접장 거리를 유지하면서 샘플을 주사하므로 데이터 전송 속도가 낮고⁽¹⁾ 100nm 개구를 통과한 빛의 광전달율은 10^{-5} 만큼 떨어진다.⁽²⁾ 이러한 단점을 보완하기 위해 많은 연구그룹에서 Si 공정을 통한 나노 탐침 배열을 제작해왔다.^(1,3) 나노 탐침을 2차원으로 배열하면 고밀도의 빛을 여러 위치에 동시 집적할 수 있고, 데이터 전송속도를 향상시킬 수 있다. 본 연구에서는 이와 같은 초고속 주사 및 동시 집적이 가능한 고강도 나노 슬라이드를 덮은 나노 탐침 배열을 제작하여 그 특성을 평가하였다.

본 연구실에서는 이전 연구를 통해 근접장 광섬유 탐침의 새로운 개념인 나노 탐침 슬라이드⁽⁴⁾를 제작하였는데 나노 슬라이드로서 PECVD Si_3N_4 막을 이용하였다. 이러한 나노 슬라이드는 개구를 제조하기 위한 Si 식각시 KOH 용액을 사용하는 과정에서 PECVD Si_3N_4 막도 조금씩 식각되는 단점을 지니고 있었다. 본 연구에서는 이러한 단점을 보완하여 LPCVD Si_3N_4 막이 증착된 나노 탐침을 제작하였다. LPCVD Si_3N_4 막은 광학적으로 투명하여 광투과성이 뛰어나고, PECVD Si_3N_4 막보다 견고성이 강하므로 공정과정에서 LPCVD Si_3N_4 막을 증착시켜 나노 슬라이드 역할을 향상시켰다. 그림1 (a)는 제작된 나노 탐침의 측면사진이다. 나노 슬라이드와 개구부분을 확대하여 관측한 결과 30nm 두께의 LPCVD Si_3N_4 막이 잘 형성되었음을 알 수 있었다(그림1 (b)).

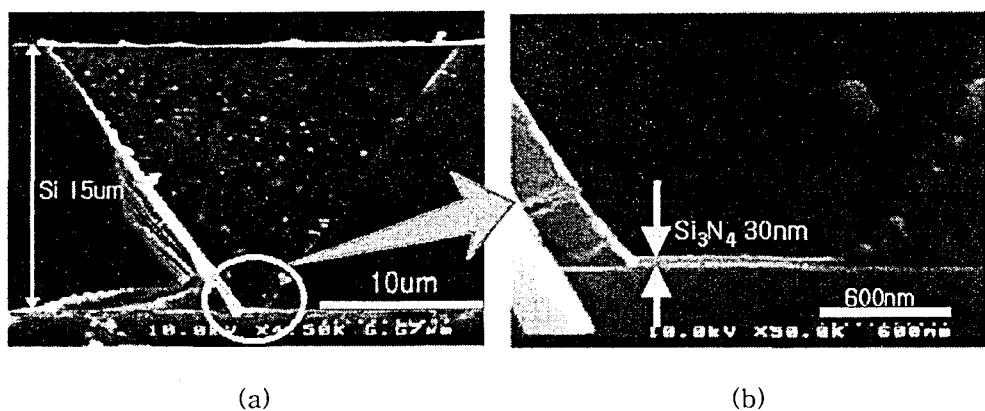


그림1. LPCVD Si_3N_4 막이 증착된 나노 탐침의 측면(SEM image)

나노 탐침의 배열구조는 광 리소그래피 공정상에서 다양한 크기의 마스크 배열을 이용하여 개구 크기를 수십 nm 부터 수 um 까지 순차적으로 증가하는 형태로 제작할 수 있었다. 여러 종류의 개구 크기를 배열함으로써 원하는 개구 크기를 선택하여 실험을 할 수 있는 장점과 다양한 나노 구조 물질을 각각 다른 개구에서 측정할 수 있는 장점이 있다. 투과형 현미경으로 나노 탐침 배열을 관측한 결과 개구 크기는 마스크에 따라 파장이하부터 수um까지 다양하게 형성되었음을 알 수 있었다(그림2 (a), $\times 100$ microscopic image). SEM사진과의 대조결과 개구 크기가 약 200nm 이상인 탐침은 현미경 조명으로도 관측할 수 있었다. 그림 2 (b)는 100nm 크기의 나노 탐침에 대한 SEM($\times 200,000$)사진이다. 이와 같이 본 연구에서는 근접장 측정을 위한 고강도 LPCVD Si₃N₄를 나노 슬라이드로 이용한 나노 탐침을 제작하였으며 여러 크기의 개구들을 배열형태로 제조하였다. 본 연구는 과학기술부 국가지정연구실사업(M1-0203-00-0082) 지원을 받아 수행되었습니다.

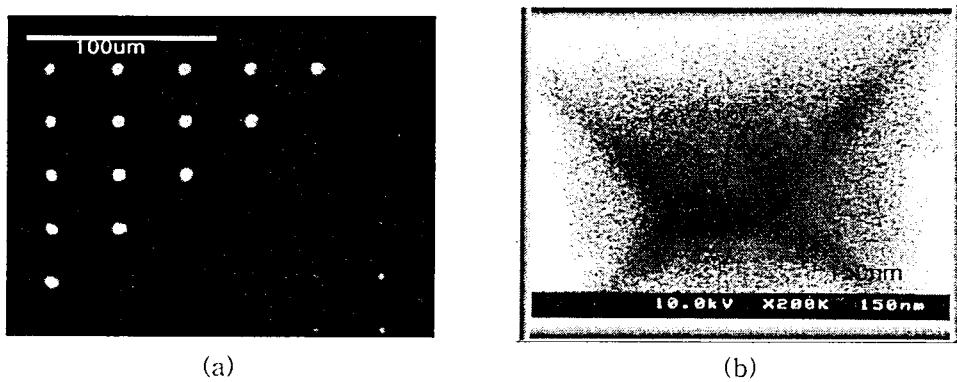


그림2. (a) 나노 탐침 배열
(b) 개구가 100nm인 나노 탐침의 SEM 사진

F
B

- Lee, M. B., Kuroogi, M., Yatsui, T., Tsutsui, K., Atoda, N., and Ohtsu, M., Appl. Opt. 38, 3566 (1999).
- Saiki, T., Mononobe, S., Ohtsu, M., Saito, N., and Kusano, J., Appl. Phys. Lett. 58, 2612 (1996).
- Phan Ngoc Minh, Takahito Ono, Shuji Tanaka, Kenya Goto and Masayoshi Esashi, Sensors and Actuators A 95, 168 (2002).